



СДЕЛАНО В СССР

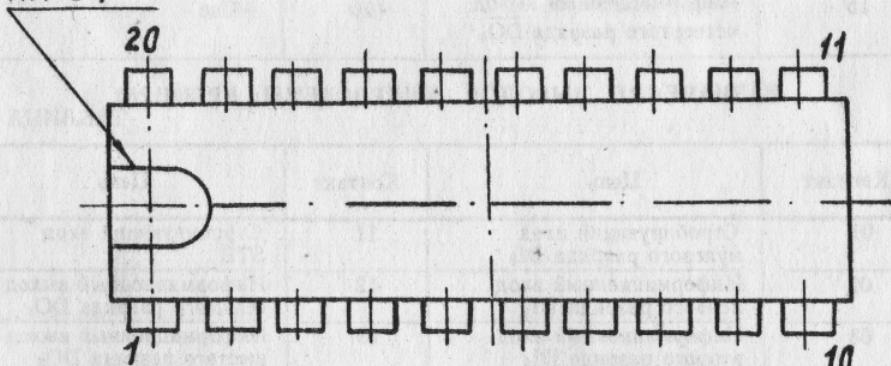
МИКРОСХЕМЫ КР580ИР82  
КР580ИР83

Заказ-наряд № \_\_\_\_\_

### 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Микросхемы КР580ИР82 представляют 8-разрядный буферный регистр без инверсии, с тремя состояниями на выходе (УВВ) для микропроцессорных комплектов, микросхемы КР580ИР83 представляют 8-разрядный буферный регистр с инвертированием, с тремя состояниями на выходе (УВВ) для микропроцессорных комплектов.

**КЛЮЧ**



Масса не более 4 г.

### НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ МИКРОСХЕМЫ КР580ИР83

ТАБЛИЦА 1

Контакт	Цель	Контакт	Цель
01	Информационный вход нулевого разряда DI <sub>0</sub>	06	Информационный вход пятого разряда DI <sub>5</sub>
02	Информационный вход первого разряда DI <sub>1</sub>	07	Информационный вход шестого разряда DI <sub>6</sub>
03	Информационный вход второго разряда DI <sub>2</sub>	08	Информационный вход седьмого разряда DI <sub>7</sub>
04	Информационный вход третьего разряда DI <sub>3</sub>	09	Вход разрешения выхода OE
05	Информационный вход четвертого разряда DI <sub>4</sub>	10	Общий

## НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ МИКРОСХЕМЫ КР580ИР83

Продолжение табл. 1

Контакт	Цепь	Контакт	Цепь
11	Стробирующий вход STB	16	Стробирующий вход третьего разряда DO <sub>3</sub>
12	Информационный выход седьмого разряда DO <sub>7</sub>	17	Информационный выход второго разряда DO <sub>2</sub>
13	Информационный выход шестого разряда DO <sub>6</sub>	18	Информационный выход первого разряда DO <sub>1</sub>
14	Информационный выход пятого разряда DO <sub>5</sub>	19	Информационный выход нулевого разряда DO <sub>0</sub>
15	Информационный выход четвертого разряда DO <sub>4</sub>	20	+Ucc

## НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ МИКРОСХЕМЫ КР580ИР82

ТАБЛИЦА 2

Контакт	Цепь	Контакт	Цепь
01	Стробирующий вход нулевого разряда DI <sub>0</sub>	11	Стробирующий вход STB
02	Информационный вход первого разряда DI <sub>1</sub>	12	Информационный выход седьмого разряда DO <sub>7</sub>
03	Информационный вход второго разряда DI <sub>2</sub>	13	Информационный выход шестого разряда DO <sub>6</sub>
04	Информационный вход третьего разряда DI <sub>3</sub>	14	Информационный выход пятого разряда DO <sub>5</sub>
05	Информационный вход четвертого разряда DI <sub>4</sub>	15	Информационный выход четвертого разряда DO <sub>4</sub>
06	Информационный вход пятого разряда DI <sub>5</sub>	16	Информационный выход третьего разряда DO <sub>3</sub>
07	Информационный вход шестого разряда DI <sub>6</sub>	17	Информационный выход второго разряда DO <sub>2</sub>
08	Информационный вход седьмого разряда DI <sub>7</sub>	18	Информационный выход первого разряда DO <sub>1</sub>
09	Вход разрешения выхода OE	19	Информационный выход нулевого разряда DO <sub>0</sub>
10	Общий	20	+Ucc

## 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

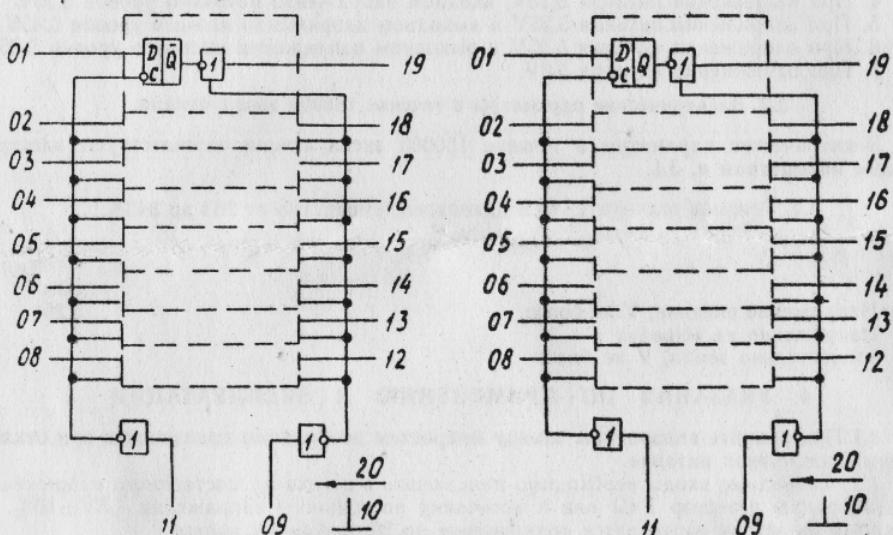
2.1. Микросхемы допускают эксплуатацию в условиях и после воздействия на них следующих механических нагрузок:

- вибрационные нагрузки в диапазоне частот от 1 до 2000Hz с ускорением до 10g;
- многократные удары с ускорением 75g;
- линейные нагрузки с ускорением 50g.

2.2. Микросхемы допускают эксплуатацию в условиях воздействия на них следующих климатических факторов:

- температуры окружающей среды от 263 до 343°К;
- смены температур от 263 до 343°К.

### ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА КР580ИР82 КР580ИР83



### 3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

#### 3.1. Электрические параметры

ТАБЛИЦА 3

Наименование параметра	Норма		Темпера- тура °К	Приме- чание
	не менее	не более		
Выходное напряжение высокого уровня, В	2,4	—	298	1
Выходное напряжение низкого уровня, В	—	0,45	298	2
Входной ток низкого уровня, мА	—	минус 0,2	298	3
Входной ток высокого уровня, мА	—	50	298	4
Выходной ток в состоянии «выключено», мА	—	минус 50	298	5
	—	50		6
Время задержки информационного сигнала на выходе при переходе его из состояния низкого (высокого) уровня в состояние высокого (низкого) уровня относительно информационного сигнала на входе при переходе его из состояния низкого (высокого) уровня в состояние высокого (низкого) уровня, нс				
для КР580ИР82		30	298	7
для КР580ИР83	—	22		

## Примечания.

- При напряжении питания 4,75V, входном напряжении низкого уровня 0,8V, входном напряжении высокого уровня 2,0V, выходном токе высокого уровня минус 5мА.
- При напряжении питания 4,75V, входном напряжении низкого уровня 0,8V, входном напряжении высокого уровня 2,0V, выходном токе низкого уровня 32мА.
- При напряжении питания 5,25V, входном напряжении низкого уровня 0,45V.
- При напряжении питания 5,25V, входном напряжении высокого уровня 5,25V.
- При напряжении питания 5,25V и выходном напряжении низкого уровня 0,45V.
- При напряжении питания 5,25V и выходном напряжении высокого уровня 5,25V.
- При напряжении питания 5,0V.

## 3.2. Электрические параметры в течение 15000h эксплуатации.

Электрические параметры в течение 15000h эксплуатации соответствуют электрическим параметрам п. 3.1.

## 3.3. Режимы эксплуатации в диапазоне температур от 263 до 343К.

предельно  
допустимый  
режим

5,25

Напряжение питания, V не более

Напряжение на выводах  
относительно земли, V не более

## 4. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1 При ремонте аппаратуры замену микросхем необходимо производить при отключенных источниках питания.

4.2. Свободные входы необходимо подключать к источнику постоянного напряжения  $5V \pm 5\%$  через резистор  $1k\Omega$  или к источнику постоянного напряжения  $4,5V \pm 10\%$ . К каждому резистору допускается подключение до 20 свободных входов.

При работе с микросхемами должны быть приняты меры по защите от воздействия электростатического заряда. Допустимое значение электростатического потенциала 30V.

При расчетах и конструировании аппаратуры рекомендуется руководствоваться следующим:

— значения напряжений низкого и высокого уровня на входе с учетом воздействия помех не должны превышать в рабочем режиме 0,8V и быть ниже 2V, соответственно;

— использовать режим короткого замыкания в качестве режима рабочей нагрузки не допускается.

4.3. При эксплуатации микросхем рекомендуется принимать меры, обеспечивающие минимальную температуру нагрева микросхем и защиту от воздействия климатических факторов.

Такими мерами являются: улучшение вентиляции, рациональное размещение микросхем в блоках, применение теплоотводящих панелей и экранов, заливки компаундами.

## 5. ХРАНЕНИЕ

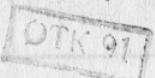
Микросхемы следует хранить в упаковке предприятия-изготовителя, вмонтированными в аппаратуру и в комплекте ЗИП при температуре от 278 до 313К и относительной влажности воздуха 80% при 298K для отапливаемых хранилищ:

— при температуре от 213 до 323K и относительной влажности воздуха 40% при 323K для хранилищ с регулируемой влажностью;

— при температуре от 278 до 288K и относительной влажности воздуха 55% при 288K для хранилищ с регулируемой температурой и влажностью.

Микросхемы соответствуют техническим условиям.

Место для штампа ОТК.



881118